

PNP 中功率放大三极管
 PNP Medium Power Transistor

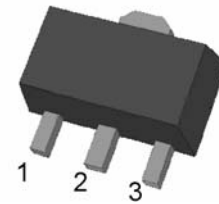
PNP Medium Power Transistor PNP 中功率放大三极管

FHFCX593

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特点

Medium Power Amplifier 中等功率放大
 Complement to FHFCX493

SOT-89



PIN ASSIGNMENT 引脚说明

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-89	
B	1	BASE
C	2	COLLECTOR
E	3	EMITTER

MAXIMUM RATINGS(T_a=25°C) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	V _{CEO}	-100	Vdc
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	V _{CBO}	-120	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	V _{EBO}	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集电极电流-连续	I _C	-1.0	Adc
Base Current 基极电流	I _B	-200	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Power Dissipation 耗散功率	P _{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range 储存温度	T _J :T _{stg}	-65 ~ 150	°C

DEVICE MARKING 打标

FHFCX593=P93(100~300)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

(T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	V _{(BR)CEO}	I _C =-10mA,	-100	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	V _{(BR)CBO}	I _C =-100μA	-120	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	V _{(BR)EBO}	I _E =-100μA	-5.0	—	—	V
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} =-100V	—	—	-100	nA
	I _{CES}	V _{CE} =-100V	—	—	-100	
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =-4V, I _C =0	—	—	-100	nA
DC Current Gain 直流电流增益	h _{FE1}	V _{CE} =-5V, I _C =-1mA	100	—	—	
	h _{FE2}	V _{CE} =-5V, I _C =-250mA	100	—	—	
	h _{FE3}	V _{CE} =-5V, I _C =-500mA	100	—	300	
	h _{FE4}	V _{CE} =-5V, I _C =-1.0A	50	—	—	

PNP 中功率放大三极管
 PNP Medium Power Transistor

PNP Medium Power Transistor

PNP 中功率放大三极管

FHFCX593

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-250mA, I_B=-25mA$	—	—	-200	mV
		$I_C=-500mA, I_B=-50mA$	—	—	-300	mV
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$	—	—	-1.1	V
Base-Emitter Turn on Voltage 基極-發射極開啓電壓	$V_{BE(on)}$	$I_C=-1A, V_{CE}=-5V$			-1.0	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=-10V, I_E=-50mA,$ $f=100MHZ$	50	—	—	MHz
Collect Output Capacitance 輸出電容	C_{Ob}	$V_{CB}=-10V, f=1MHZ$	—	—	5	pF